

达林顿晶体管阵列电路

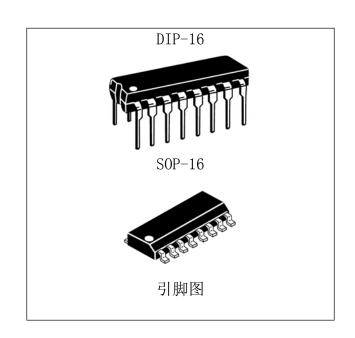
概述

ULN2003M 是高压、大电流达林顿晶体管阵列单片集成电路。适用于工业及民用各类灯具,继电器及打印机撞针的驱动。

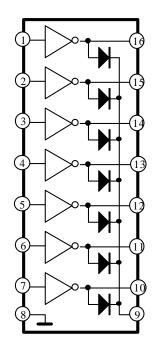
采用 DIP16 和 SOP16 封装形式。

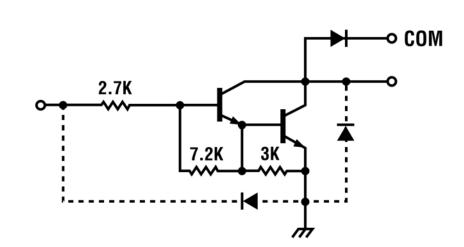
主要特点

- 耐压高,输出工作电压可达 40V
- 内设过压保护电路,防止由感应负载引入的过压损害
- 峰值涌入电流达 600mA,可以驱动白炽 灯
- 输入阻抗为 2. 7kΩ,可与使用 5V 电压的 TTL 或 CMOS 逻辑电路配合使用



功能框图







极限值(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃)

参数名称	符号		数值		単位
多	17 5	最 小	典型	最 大	
输出电压 ¹	Vo			40	V
输入电压	VI			30	V
集电极电流 (连续电流)	Ic			500	mA
基极电流 (连续电流)	IB			25	mA
结温	Tj			150	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
工作环境温度	Tamb	-20		85	$^{\circ}$ C
贮存温度	Tstg	-55		150	°C
COM 到 GND 击穿电压 1 (曲线 1)	VCOMbd		90		V
OUT 到 GND 击穿电压 ² (曲线 2)	Vobd		90		V

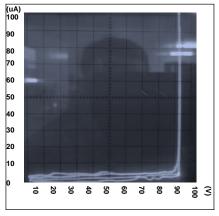
注1、注2: 此电压值为该引脚的击穿电压典型值,非最大工作电压。

电特性 (若无其它规定, Tamb=25℃)

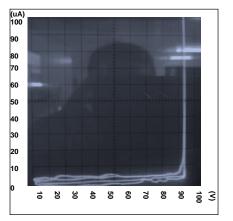
特 性	符号	测试条件		规 范 值			单
₩	15 5			最 小	典 型	最 大	位
松山泥山沟	ICEV	Vo=40V, Tamb=	+85°C			100	
输出漏电流 	ICEX	Vo=40V, Tamb= +25°C				50	μA
存中权 华科拉拉	VCES	Ic=350mA, IB=		1.1	1.6	V	
集电极一发射极输出饱 和压降		Ic=200mA, IB=350μA			0.95		1.3
↑H/下片鞋		Ic=100mA, IB=250μA			0.85		1.1
输入电流(导通条件下)	II (ON)	VI=3. 85V			0. 93	1. 35	mA
	VI (ON)	VCE=2.0V, Ic=200mA				2.4	
输入电压(导通条件下)		VCE=2.0V, Ic=250mA				2.7	V
		VCE=2.0V, Ic=300mA				3.0	
输入电流(关断条件下)	II (OFF)	VCE=2.0V, Ic=350mA		50	100		μA
输入电容	CI				15	30	pF
导通延迟时间	tON	50%EI 到 50%Eo			0. 25	1.0	μs
截止延迟时间	t0FF	50%EI 到 50%Eo 0.25		1.0	μs		
第位二极管漏电流 第位二极管漏电流	电流 IR VR=50V Tamb= +25℃		50				
担心一似目病电机	11/	V V-20V	Tamb= +85℃			100	μA
箝位二极管正向电压	VF	IF=350mA			1.5	2.0	V



功耗曲线 (若无其它规定, Tamb=25℃)

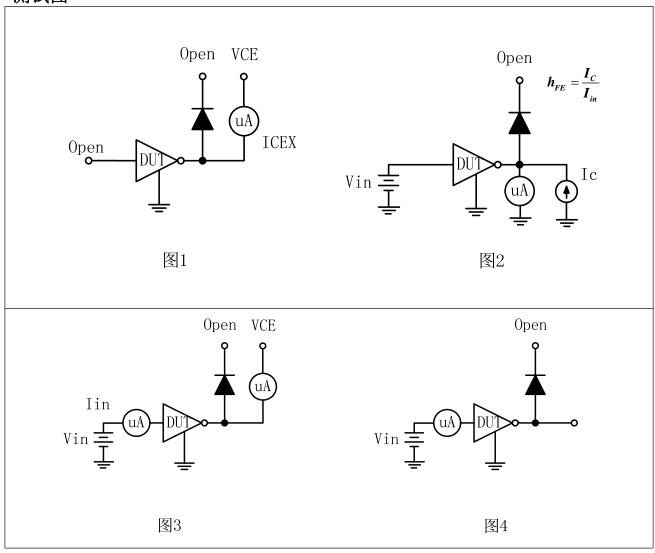


曲线 1. COM-GND 耐压图

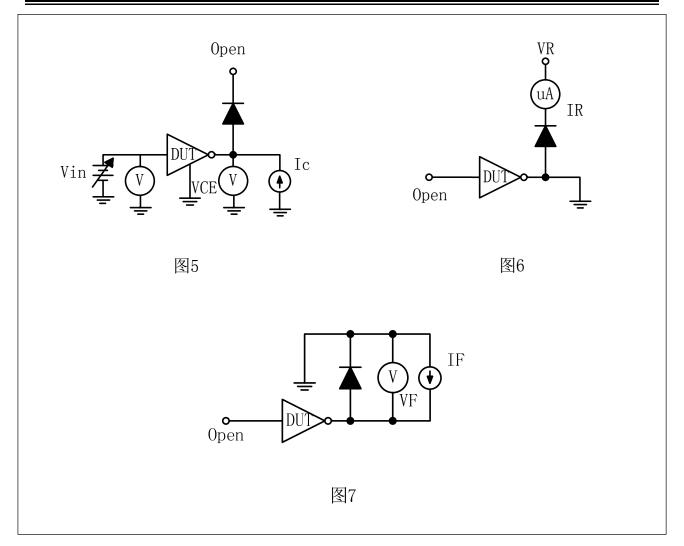


曲线 2. OUT-GND 耐压图

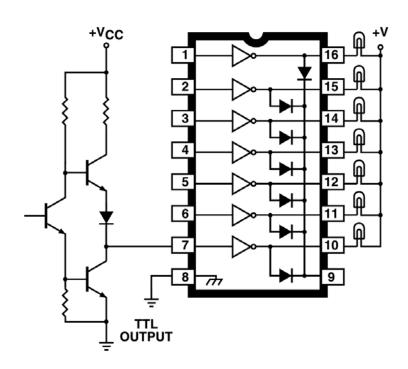
测试图







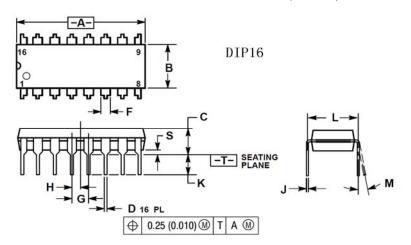
应用电路图





封装尺寸

(DIP16)



	INC	INCHES		MILLIMETERS		
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX		
Α	0.740	0.770	18.80	19.55		
В	0.250	0.270	6.35	6.85		
C	0.145	0.175	3.69	4.44		
D	0.015	0.021	0.39	0.53		
F	0.040	0.70	1.02	1.77		
G	0.100 BSC		2.54 BSC			
Н	0.050 BSC		1.27 BSC			
J	0.008	0.015	0.21	0.38		
K	0.110	0.130	2.80	3.30		
L	0.295	0.305	7.50	7.74		
M	0 °	10 °	0 °	10 °		
S	0.020	0.040	0.51	1.01		

(SOP16)

